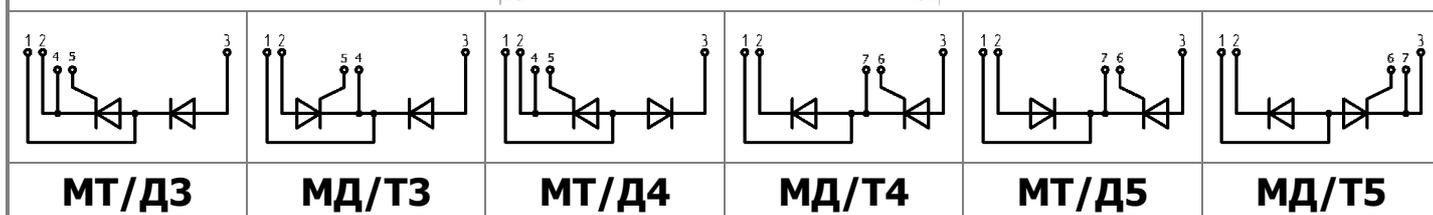
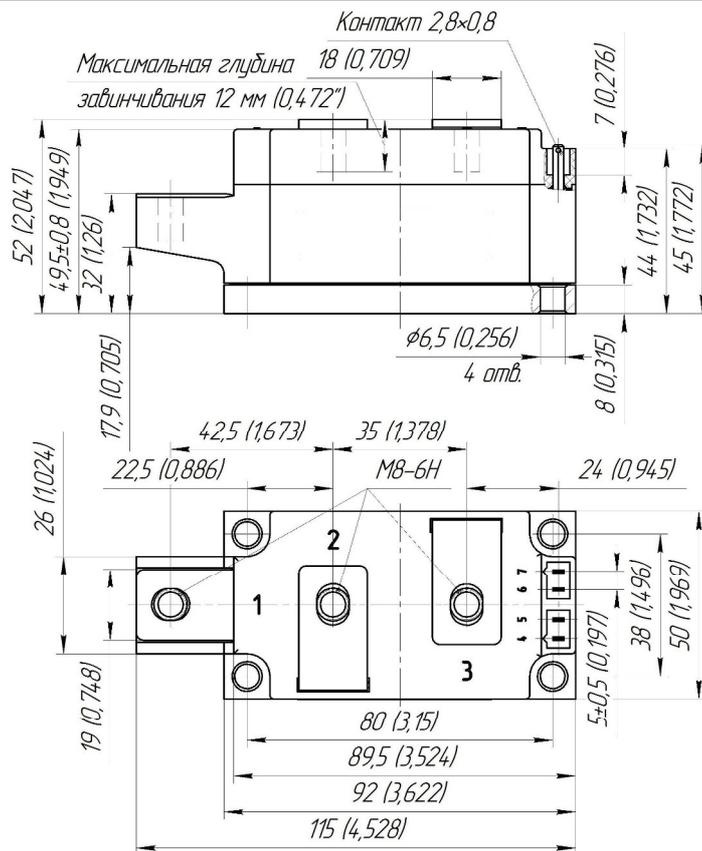
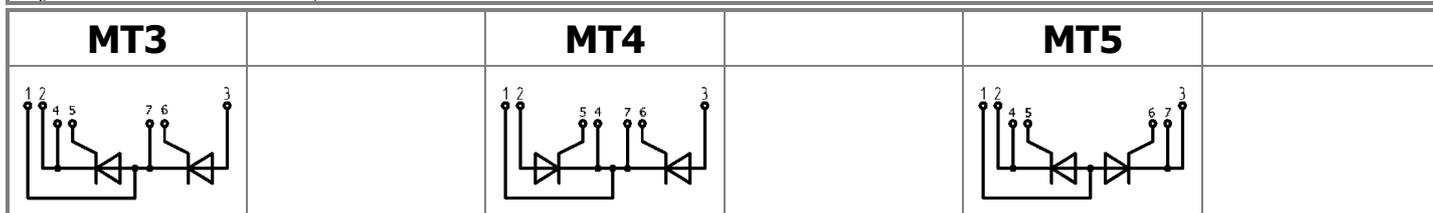




Изолированное основание
 Корпус промышленного стандарта
 Упрощенная механическая конструкция,
 быстрая сборка
 Прижимная конструкция

Двухпозиционный Тиристорный Модуль МТх-160-36-С1

Средний прямой ток	I_{TAV}	160 А		
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	U_{DRM}	3000 ÷ 3600 В		
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}			
Время выключения	t_q	300 мкс		
$U_{DRM}, U_{RRM}, В$	3000	3200	3400	3600
Класс по напряжению	30	32	34	36
$T_{ij}, °C$	- 40 ÷ 125			



Все размеры в миллиметрах (дюймах)

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения
Параметры в проводящем состоянии				
I_{TAV}	Средний ток в открытом состоянии	А	160 169	$T_c = 88\text{ °C}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц $T_c = 85\text{ °C}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц
I_{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии	А	251	$T_c = 88\text{ °C}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии	кА	4.0 4.6	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ °C}$ 180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p = 10\text{ мс}$); единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В}$; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$; $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
			5.0 5.8	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ °C}$ 180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p = 8.3\text{ мс}$); единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В}$; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$; $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
I^2t	Защитный фактор	$A^2c \cdot 10^3$	80 105	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ °C}$ 180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p = 10\text{ мс}$); единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В}$; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$; $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
			100 135	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ °C}$ 180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p = 8.3\text{ мс}$); единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В}$; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$; $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
Блокирующие параметры				
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	3000÷3600	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	3100÷3700	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто
U_D, U_R	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.75 \cdot U_{DRM}$ $0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\max}$; управление разомкнуто
Параметры управления				
I_{FGM}	Максимальный прямой ток управления	А	6	$T_j = T_{j\max}$
U_{RGM}	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
P_G	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	3	$T_j = T_{j\max}$ для постоянного тока управления
Параметры переключения				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f = 1\text{ Hz}$)	А/мкс	200	$T_j = T_{j\max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; $I_{TM} = 2 I_{TAV}$; Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}$; $t_{GP} = 50\text{ мкс}$; $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
Тепловые параметры				
T_{stg}	Температура хранения	°C	-40 ÷ 50	
T_j	Температура р-п перехода	°C	-40 ÷ 125	
Механические параметры				
a	Ускорение	м/с ²	50	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения		
Характеристики в проводящем состоянии						
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	2.50	$T_j=25\text{ °C}; I_{TM}=785\text{ A}$		
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.20	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$		
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	2.300			
I_L	Ток включения, макс	мА	700	$T_j=25\text{ °C}; U_D=12\text{ В};$ Импульс управления: $I_G=2\text{ A};$ $t_{GP}=50\text{ мкс}; di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$		
I_H	Ток удержания, макс	мА	300	$T_j=25\text{ °C};$ $U_D=12\text{ В};$ управление разомкнуто		
Блокирующие характеристики						
I_{DRM}, I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	50	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $U_D=U_{DRM}; U_R=U_{RRM}$		
$(dv_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, мин	В/мкс	1000	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $U_D=0.67 \cdot U_{DRM};$ управление разомкнуто		
Характеристики управления						
U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	3.50 2.00 1.50	$T_j=T_{j\text{ min}}$ $T_j=25\text{ °C}$ $T_j=T_{j\text{ max}}$	$U_D=12\text{ В}; I_D=3\text{ A};$ Постоянный ток управления	
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, макс	мА	250 150 100	$T_j=T_{j\text{ min}}$ $T_j=25\text{ °C}$ $T_j=T_{j\text{ max}}$		
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.25	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $U_D=0.67 \cdot U_{DRM};$		
I_{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	мА	10.00	Постоянный ток управления		
Динамические характеристики						
t_{gd}	Время задержки включения	мкс	3.00	$T_j=25\text{ °C}; V_D=0.4 \cdot U_{DRM}; I_{TM}=I_{TAV};$ Импульс управления: $I_G=2\text{ A};$ $t_{GP}=50\text{ мкс}; di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$		
t_q	Время выключения, макс	мкс	300	$dv_D/dt=50\text{ В/мкс}; T_j=T_{j\text{ max}}; I_{TM}=I_{TAV};$ $di_R/dt=-10\text{ А/мкс}; U_R=100\text{ В};$ $U_D=0.67 U_{DRM}$		
Тепловые характеристики						
R_{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс			180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10\text{ мс}$)		
		на модуль	°C/Вт			0.0550
		на позицию	°C/Вт			0.1100
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс					
		на модуль	°C/Вт			0.0200
		на позицию	°C/Вт			0.0400
Характеристики изоляции						
U_{ISOL}	Электрическая прочность изоляции	кВ	3.00	синус; 50 Гц; действующее значение	$t=1\text{ мин}$	
			3.60		$t=1\text{ с}$	
Механические характеристики						
M_1	Момент затяжки основания ($M6$) ¹⁾	Нм	6.00	Допуск $\pm 15\%$		
M_2	Момент затяжки выводов ($M8$) ¹⁾	Нм	9.00	Допуск $\pm 15\%$		
w	Масса, тип	г	800			

МАРКИРОВКА						ПРИМЕЧАНИЕ			
МТ	3	-	160	-	36	-	С1	-	У2
1	2		3		4		5		6
1. Тиристорный модуль (МТ) Тиристорно-диодный модуль (МТ/Д) Диодно-тиристорный модуль (МД/Т) 2. Схема включения 3. Средний прямой ток, А 4. Класс по напряжению 5. Тип корпуса (М.С1) 6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У2									
						1) Резьба должна быть смазана			

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав.
 В интересах улучшения качества продукции, ЗАО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.